直線集束ビーム超音波材料解析システムによる

圧電性 Ta₂0₅ 薄膜の評価

Evaluation of piezoelectric Ta_2O_5 thin film by the line-focus-beam ultrasonic material characterization system

^O末永 凌大¹, 鈴木 雅視¹, 垣尾 省司¹, 大橋 雄二², 荒川 元孝², 櫛引 淳一²

(1. 山梨大学, 2. 東北大学)

[°]Ryota Suenaga¹, Masashi Suzuki¹, Shoji Kakio¹, Yuji Ohashi², Mototaka Arakawa², Jun-ichi Kushibiki²

(1. Univ. of Yamanashi, 2. Tohoku Univ.)

E-mail: g17te014@vamanashi.ac.jp

1.はじめに

直線集束ビーム超音波材料解析(LFB-UMC) システムは,弾性波デバイスに用いられる基板 や薄膜材料の弾性的性質を非破壊・非接触で高 精度に定量計測可能な手法である[1]. この手法 では,水を負荷した試料表面を伝搬する漏洩弾 性表面波(Leaky SAW: LSAW)の位相速度と規 格化伝搬減衰を測定する. 伝搬減衰の測定値か ら,水への漏洩損失の理論値を差し引くことで, 材料の音響損失を評価できる可能性がある. 著 者らは、アモルファス Ta2O5 薄膜を装荷した 128°Y-X LiNbO₃ 試料上に形成したすだれ状電 極(IDT)を用いて、水負荷時の伝搬損失の測定 値から水への漏洩損失の理論値を差し引くこ とによる音響損失評価の可能性を示した^[2].

本報告では、圧電性 Ta₂O₅薄膜を取り上げて、 LFB-UMCシステムを用いてLSAWの位相速度 と伝搬減衰を測定し,理論値と比較した結果に ついて述べる.

2. 試料作製

合成石英ガラス基板上に, RF スパッタリン グ装置を用いて、X 軸配向圧電性 Ta₂O₅薄膜を 成膜し, 膜厚 H=1.8~7.0 µm を有する試料を作 製した.成膜条件は,基板温度,Ar:O₂ガス流 量比, 成膜中の雰囲気ガス圧, RF 電力を, そ れぞれ 750 °C, 30:10 sccm, 0.75 Pa, 150 W と した. また, レイリー波(R-SAW)の伝搬損失を 測定するために,薄膜上に送受 IDT 対(波長λ=8 μm)を形成した試料も作製した.

3. 実験

LFB-UMC システムを用いて, LSAW の位相 速度と規格化減衰を周波数 f=100-300 MHz の 範囲で測定した. Ta₂O₅の膜厚 H と f の積 fH に 対する LSAW の位相速度を Fig. 1, 規格化減衰 を Fig. 2 に示す. 図中には, 理論値, および IDT を用いて測定したLSAW 速度とR-SAW の伝搬 損失も示す.理論計算に用いた Ta,O5の材料定 数は Nakagawa らの報告値である^[3].

Fig.1より, 0th mode の位相速度の測定値は, 理論値と概ね一致している.しかし、 fH=400-1000 Hz·m の間で,測定値は単調に減



Fig. 2 Normalized attenuation vs *fH* for LSAW.

少するのに対して,理論値は減少した後わずか に増加する傾向があり,両者の間に相違がみら れる. 1st mode では、LFB-UMC と IDT の何れ も測定値と理論値の間に大きな差がある.

Fig. 2 より, IDT で測定した R-SAW の伝搬 損失(0.23 dB/λ, fH=1289 Hz·m)は、減衰測定値 と水への漏洩損失理論値の差分と同じオーダ ーであった.しかし、音響損失に相当すると考 えられるその差分は、fH に対して単調に増加 するはずであるが、その傾向はみられない、

薄膜の弾性特性は作製条件に強く依存する ことから,今後,Ta₂O₅の材料定数を再算定し, 音響損失を評価する.

参考文献

J. Kushibiki and N. Chubachi: IEEE Trans. Sonics [1]Ultrason. **SU-32** (1985) 189.

R. Suenaga, *et al.*: The 38th Symposium on ULTRASONIC ELECTRONICS, 1P2-7 (2017).
Y. Nakagawa and T. Okada: J. Appl. Phys. **68** (1990) 556.